特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]



出願人又は代理人 の 告類記号 146686-115	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP2004/004070	国際出願日(日.月.年) 24.03.2004	優先日 (日.月.年) 25.03.2003				
国際特許分類(I P C) Int.Cl. ⁷ H01L21/314, 21/31						
出願人(氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社						

1.	この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2.	この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。
	この報告には次の附属物件も添付されている。 1. ア 附属書類は全部で <u></u>
	▼ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)
	「 第 I 欄 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙
b	・ 「 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。
	配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第 802 号参照)
4.	この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
	 ▼ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 〒 第 II 欄 優先権 「 第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第 IV 欄 発明の単一性の欠如 第 V 欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 「 第 VI 欄 ある種の引用文献 「 第 VI 欄 国際出願の不備 「 第 VI 欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 25.01.2005	国際予備審査報告を作成した日 15.07.2005		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 今井 拓也		
東京都千代田区飯が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3471		

第I欄	報告の基礎	<u> </u>		
	s control to the constraint of the last -	T201 - 10 A 10 A 10 A		
1. =0.)国際予備番金報告は、	下記に示す場合を除くほか	い、国際出願の言語を基礎	とした。
Γ.	この報告は、	語による翻訳文を	基礎とした。	
	_	出された翻訳文の言語であ	る。	
		F23.1(b)にいう国際調査		
<u> </u>	PCT規則12.4にV			
,	PCT規則55.2又に	は55.3にいう国際予備審査		
2. 50	対告は下記の出願書類	を基礎とした。 (法第6条	。(PCT14条)の相定に	基づく命令に応答するために提出され
た差替え	用紙は、この報告におい	いて「出願時」とし、この	報告に添付していない。	と、いうに心合するために延出され
	all a proposition of the state			
1	出願時の国際出願書類	l		
ਂ	明細書			
	第1-14	ページ、	出願時に提出されたもの	
	第 .	ページ*		付けで国際予備審査機関が受理したもの
	第	ページ*、	,	付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
₽	請求の範囲			
,•		2項、	11185504.1=46.111.4-14.4-2.m	
		<u>·</u>		
	第 1, 9	項*、	15.06.2005	付けで国際予備審査機関が受理したもの
	第	項*、		付けで国際予備審査機関が受理したもの
			•	
	図面			•
	第 1 / 7 - 7 / 7	ページ /図 、	出願時に提出されたもの	
	弗 <u>————————————————————————————————————</u>	ペーシノ凶*、		付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	At	· \= \/ \/ \/ \/ \/		りりで国际丁伽番登機関か受理したもの
Γ.	配列表又は関連するテ	ーブル 充欄を参照すること。		
	配列衣に関する相	元伽で参照すること。		
a 57	特エルトル できのかき	ニュナルログ シューエ		•
3. IV.	補正により、下記の書類	摂か削除された。		
	明細書	第	:	ページ
	マ 請求の範囲			頁
	図面	第		ページ/図
	配列表(具体的に			
	配列表に関連する	テーブル(具体的に記載す	'ること)	
4. T	この報告は、補充欄に	示したように、この報告に	添付されかつ以下に示し	た補正が出願時における開示の範囲を超
	えてされたものと認めら	っれるので、その補正がさ	れなかったものとして作り	成した。 (PCT規則 70.2(c))
	明細書	第	,	°=>
	請求の範囲	第		
	図面	第		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	配列表(具体的に記	·- · · · · ·		
	配列表に関連する	テーブル(具体的に記載す	ること)	
4 1-	サント・ロ ヘー・ニーグ	erff) we do		
* 4. €	.政ヨする場合、その用料	紙に "superseded" と記入	されることがある。	İ

育V欄 新規性、進歩性又は産業」 それを裏付ける文献及び記	上の利用可能性についての法第 12 条(PCT35 条(2))に定める見解、 説明	
1. 見解		
新規性(N)	請求の範囲 <u>1-5,9-12</u> 請求の範囲	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 <u>1-5,9-12</u> 請求の範囲	有 無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1-5,9-12</u> 請求の範囲	有 無
・ 文献及び説明(PCT規則 7	70. 7)	
【請求項 6】【請求項 7】 【0151】【0166】 文献 2~: JP 2002-22066 【請求項 5】【0019】【0	A (東京エレクトロン株式会社) 1999 06 18	0089]
で 対上であり、圧力 エンス (また) になった。 一文献 2、3には、プラ 用いられるガスとして、 一しかし、国際調査報告 の空間における電子温度 処理雰囲気の圧力19.	-12 添加カーボン膜(フルオロカーボン膜)を成膜するプラスズマにより電子温度3eV以下であり、かつ電子密度102.7Paとしたプラズマ成膜方法が記載されている。ラズマ成膜方法によってフッ素添加カーボン膜を成膜する、CsFsを使用する示唆が記載されている。きで列記した文献には、フッ素添加カーボン膜を成膜する、CsFsを使用し、かつCsFsガス供給孔と基板表面と度を2eV以下とし、かつ電子密度10 ¹² /cm³以上である5Pa以下とし、またそのように形成されるフッ素添電率2.3以下でかつリーク電流が5×10 ⁻⁸ A/cr	為にあり、カラカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ